

示。此時，跨過接面的全部靜電電位降低了 V_F ，而變成 $(V_{bi} - V_F)$ ，也使得空乏區寬度縮小。

反之，如果我們對 n 型區施加一相對於 p 型區的正電壓 V_R ，則 p-n 接面是為逆向偏壓 (reverse bias) 如圖 2-5(c) 所示。此時，跨過接面的全部靜電電位變成 $(V_{bi} + V_R)$ ，也使得空乏區寬度變大。

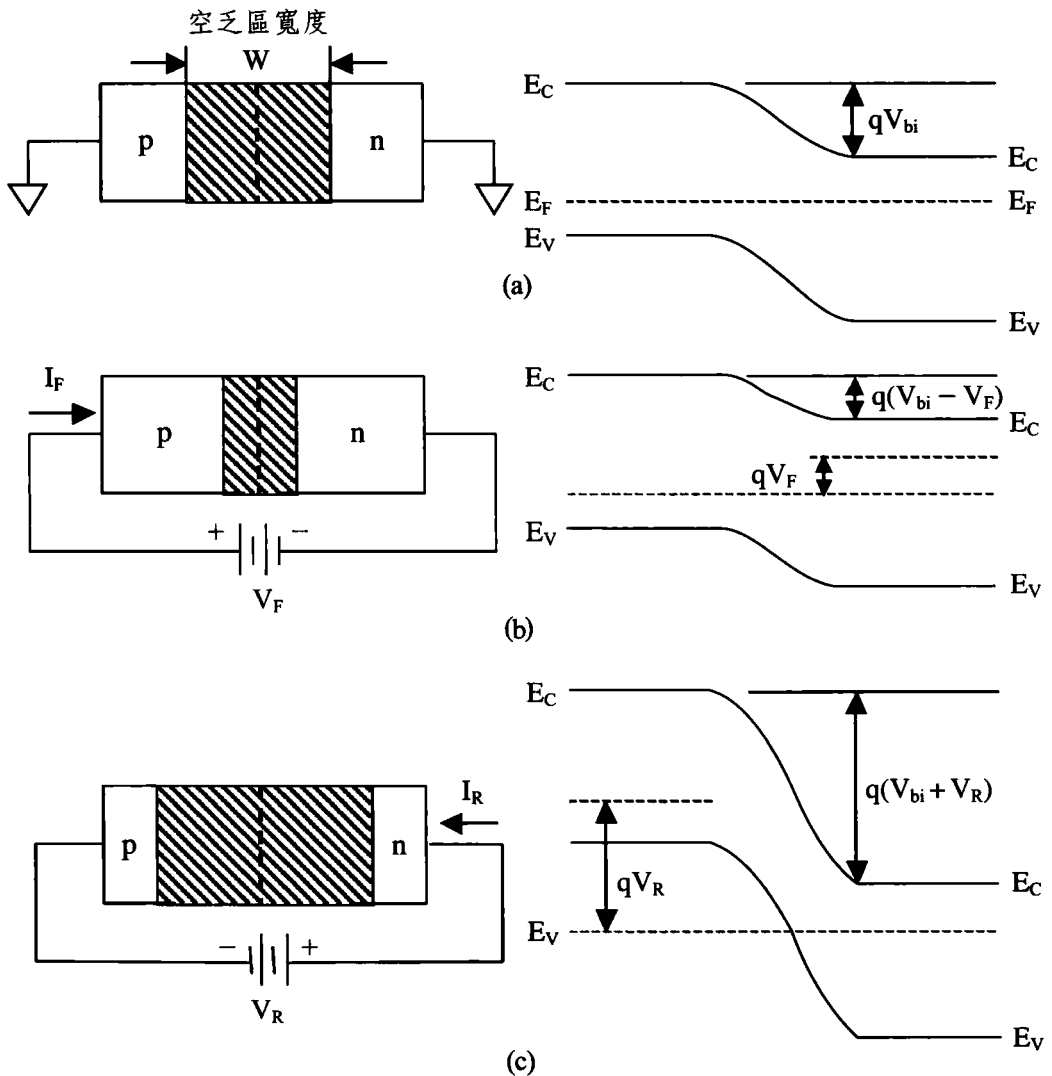


圖 2-5 在不同偏壓情況下 p-n 接面的空乏區寬度與能帶圖：

(a) 零偏壓 (b) 順向偏壓 (c) 逆向偏壓